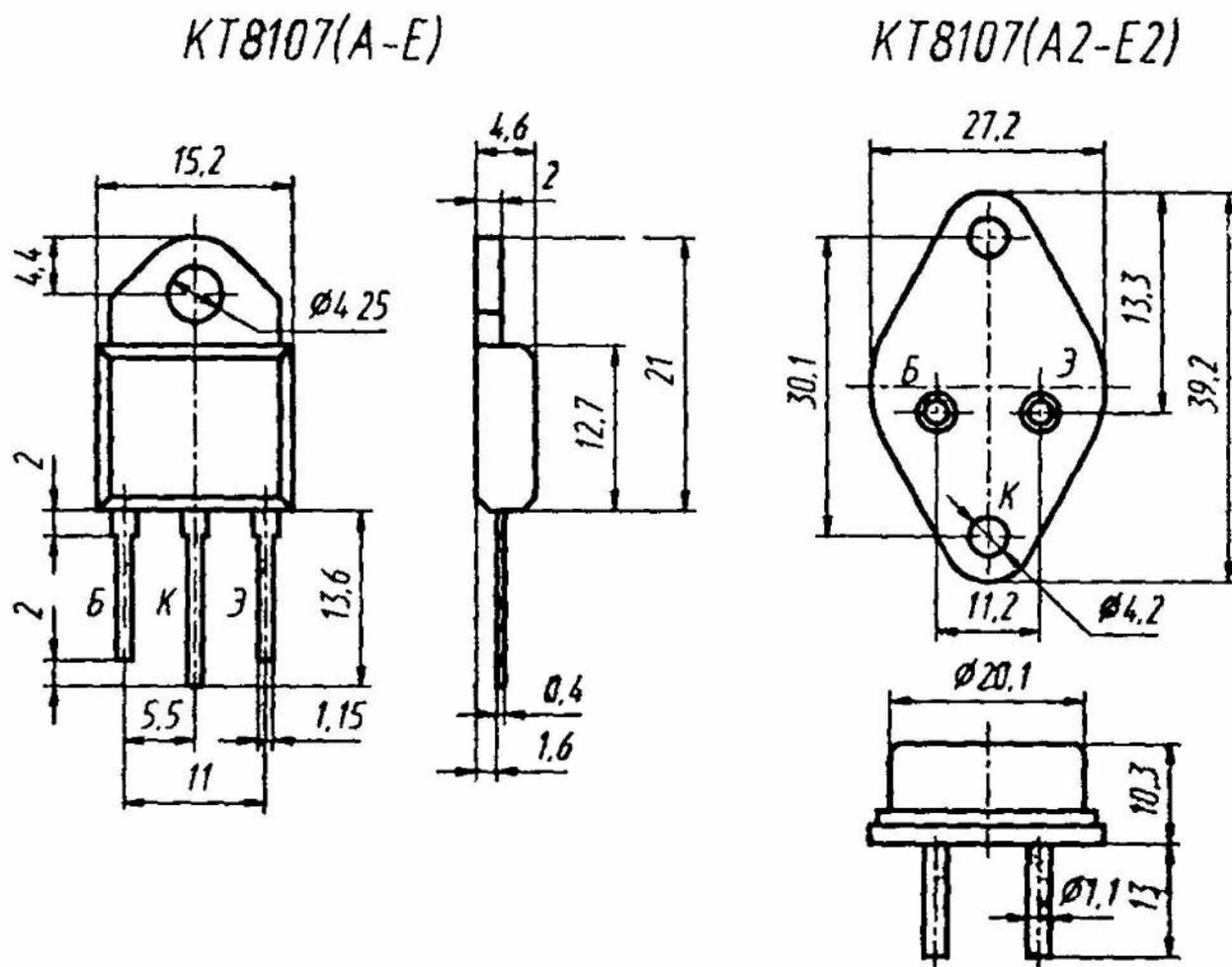


**КТ8107А, КТ8107Б, КТ8107В, КТ8107Г, КТ8107Д,
КТ8107Е, КТ8107А2, КТ8107Б2, КТ8107В2,
КТ8107Г2, КТ8107Д2, КТ8107Е2**

Транзисторы кремниевые мезопланарные структуры *n-p-n* переключательные. Предназначены для применения в схемах строчной развертки телевизионных приемников. Выпускаются в металлическом корпусе с жесткими выводами и стеклянными изоляторами КТ8107А2—КТ8107Е2 и в пластмассовом корпусе с жесткими выводами КТ8107А—КТ8107Е. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора в металлическом корпусе не более 20 г, в пластмассовом корпусе не более 4 г.

Изготовители — завод «Искра», г. Ульяновск, акционерное общество «Кремний», г. Брянск.



Электрические параметры

Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при $U_{кэ} = 5$ В, $I_k = 0,2$ А, $f = 3$ МГц, не менее	2,3
Граничное напряжение при $I_k = 0,1$ А, не менее	700 В
Напряжение насыщения коллектор—эмиттер, не более:	
КТ8107А, КТ8107А2, КТ8107В, КТ8107В2 при $I_k = 4,5$ А, $I_b = 2$ А	1 В
КТ8107Б, КТ8107Б2, КТ8107Г, КТ8107Г2 при $I_k = 4,5$ А, $I_b = 2$ А	3 В
КТ8107Д, КТ8107Д2, КТ8107Е, КТ8107Е2 при $I_k = 2,5$ А, $I_b = 1$ А	1 В
Время рассасывания при $U_{кэ} = 500$ В, $I_k = 4,5$ А, $I_b = 1,4$ А, не более	3,5 мкс
Время спада при $U_{кэ} = 500$ В, $I_k = 4,5$ А, $I_b = 1,4$ А, не более	0,5 мкс
Обратный ток коллектора при $U_{кб} = U_{кб, макс}$, не более	2 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{эб} = 6$ В, не более:	
КТ8107А, КТ8107Б, КТ8107Е, КТ8107А2, КТ8107Б2, КТ8107Е2	200 мА
КТ8107В, КТ8107Г, КТ8107Д, КТ8107В2, КТ8107Г2, КТ8107Д2	10 мА

Предельные эксплуатационные данные

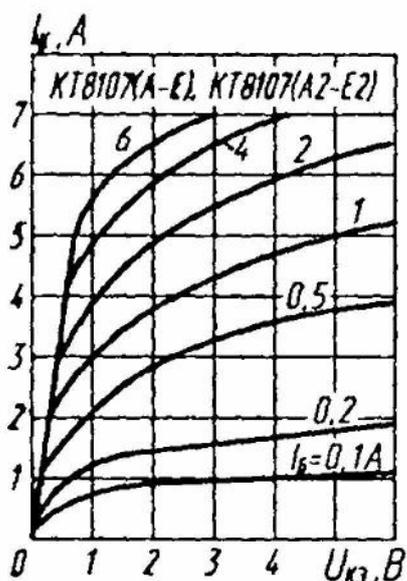
Постоянное напряжение коллектор—база:	
КТ8107А, КТ8107Б, КТ8107В, КТ8107Г, КТ8107А2, КТ8107Б2, КТ8107В2, КТ8107Г2	1500 В
КТ8107Д, КТ8107Е, КТ8107Д2, КТ8107Е2 ..	1200 В
Постоянное напряжение эмиттер—база	6 В
Постоянный ток коллектора	10 А
Импульсный ток коллектора	10 А
Постоянный ток базы	4 А
Импульсный ток базы	6 А
Импульсный запирающий ток базы	5 А
Постоянный прямой ток диода для КТ8107А, КТ8107Б, КТ8107А2, КТ8107Б2	8 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T_K \approx T_{K, \text{мин}} + 25^\circ\text{C}$	100 Вт
Температура окружающей среды:	
в металлическом корпусе	$-60 \dots T_K = +125^\circ\text{C}$
в пластмассовом корпусе	$-45 \dots T_K = +100^\circ\text{C}$

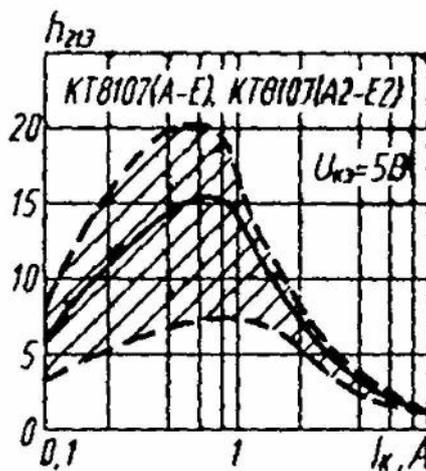
Пайка выводов транзистора допускается не ближе 5 мм от корпуса при температуре припоя не выше $+260^\circ\text{C}$ в течение не более 3 с, время лужения не более 2 с. Допускается не более трех перепаяек выводов транзистора.

Для транзисторов в пластмассовом корпусе допускается одноразовый изгиб выводов на угол не более 90° от первоначального положения в плоскости перпендикулярной основанию корпуса, не ближе 5 мм от корпуса с радиусом изгиба не менее 1,5 мм.

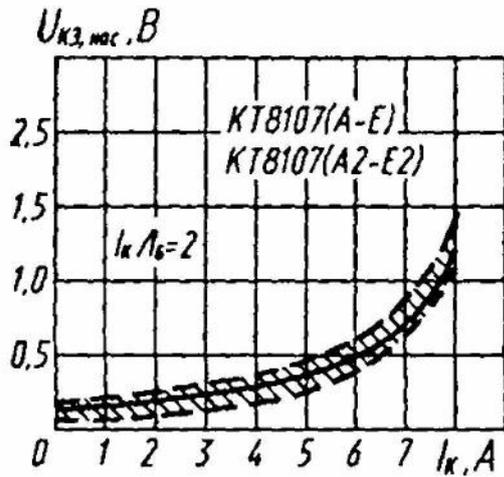
При включении транзистора в цепь, находящуюся под напряжением, базовый вывод должен присоединяться первым и отключаться последним.



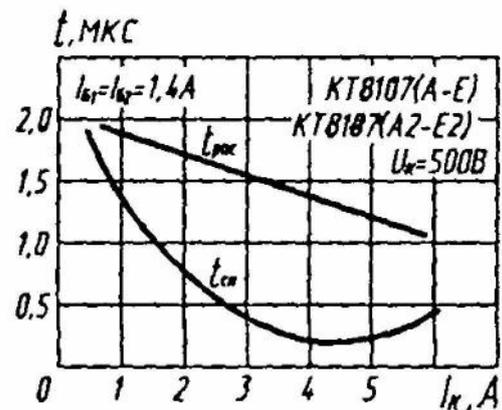
Выходные характеристики



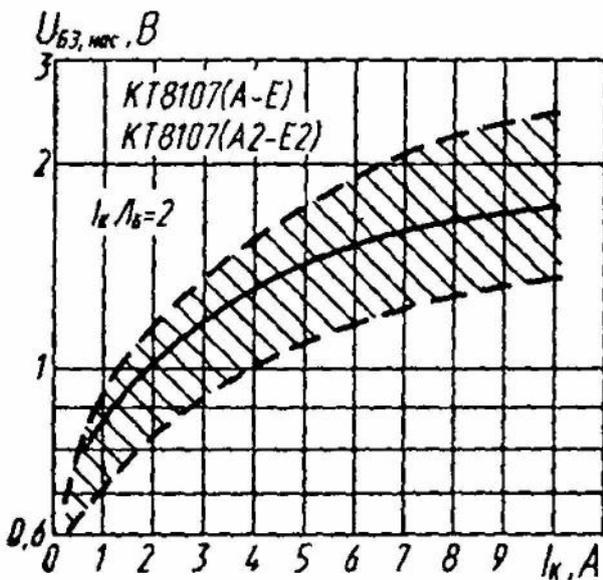
Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от тока коллектора



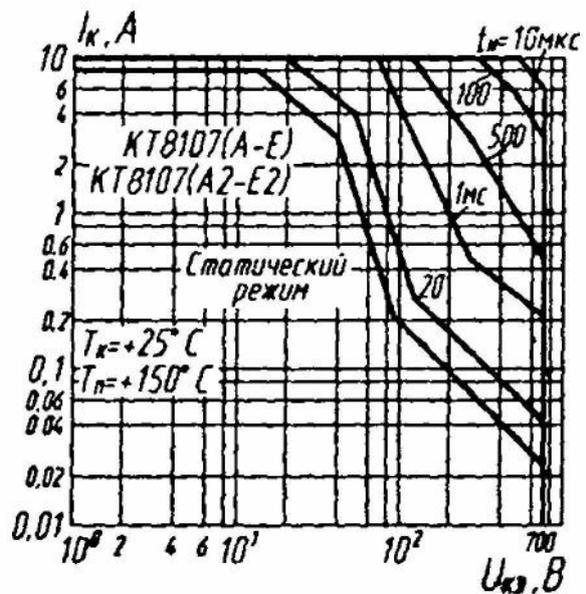
Зона возможных положений зависимости напряжения насыщения коллектор—эмиттер от тока коллектора



Зависимости времени рассасывания и времени спада от тока коллектора



Зона возможных положений зависимости напряжения насыщения база—эмиттер от тока коллектора



Области максимальных режимов